

	<h2 style="color: orange;">IPD12CNE8N G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPD12CNE8N G
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 85V 67A TO252-3
Datenblätter:	 IPD12CNE8N G.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 17585 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		



Spezifikationen

Teilenummer	IPD12CNE8N G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 85V 67A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	17585 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 83µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12.4 mOhm @ 67A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4340pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	64nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	85V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	67A (Tc)

IPD12CNE8N G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD12CNE8N G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD12CNE8N G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPD12CNE8N G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  IPD12N03LB INFINEON IPD12N03LB INFINEON	 IPD12N03L INFINEON IPD12N03L INFINEON	 IPD12N03LBG INFINEON IPD12N03LBG INFINEON	 IPD12CN10NG INFINEON IPD12CN10NG INFINEON
 IPD12N03LB G Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 30A TO-252	 IPD12CN10N G infineon IPD12CN10N G infineon	 IPD12N03LBG IPD12N03L infineon/ infineon/ SOT-252	 IPD12CN10NGBUMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 67A TO252-3

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD12CNE8N G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD12CNE8N G Datenblatt	IPD12CNE8N G-Datenblätter	IPD12CNE8N G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD12CNE8N G
IPD12CNE8N G Electronic	IPD12CNE8N G-Komponenten	IPD12CNE8N G-Verteiler	IPD12CNE8N G-Bild	IPD12CNE8N G-Teil
IPD12CNE8N G Preis	IPD12CNE8N G Hersteller	IPD12CNE8N G Bild	IPD12CNE8N G Aktie	IPD12CNE8N G Inventar
IPD12CNE8N G Neu	IPD12CNE8N G Original	IPD12CNE8N G garantiert	IPD12CNE8N G RFQ	IPD12CNE8N G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited